









	<h2>SI1300BDL-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI1300BDL-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 400MA SOT323-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI1300BDL-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 9285 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI1300BDL-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 400MA SOT323-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	9285 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 400mA (Tc) 190mW (Ta), 200mW (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-70, SOT-323
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-3
Verlustleistung (max)	190mW (Ta), 200mW (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	400mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	850 mOhm @ 250mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.84nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	35pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1300BDL-T1-E3TR

SI1300BDL-T1-E3 ist neu im Original. Suche SI1300BDL-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1300BDL-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1300BDL-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI1300DL-T1</b> SILICON SI1300DL-T1 SILICON</p>	 <p><b>SI117XG2-KIT</b> Energy Micro (Silicon Labs) THE SI117XG2-KIT EVALUATION OF S</p>	 <p><b>SI1300BDL-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 400MA SC-70-3</p>	 <p><b>SI1300DL-T1-GE3</b> V SI1300DL-T1-GE3 V</p>
 <p><b>SI12301DS-T1</b> VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p><b>SI123DL</b> SI SI DIP</p>	 <p><b>SI1300BDL-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 400MA SOT323-3</p>	 <p><b>SI13-0D</b> BESTA BESTA QFP</p>

### heiße Teile

Mehr

⊛ SI1069X-T1-E3	↔ SI1069X-T1-E3	⇒ SI1069X-T1-GE3	D SI1069X-T1-GE3	↔ SI1070X-T1-E3
↳ SI1070X-T1-E3	⊛ SI1070X-T1-GE3	D SI1070X-T1-GE3	⇒ SI1071X-T1-GE3	↔ SI1071X-T1-GE3
⊛ SI1072X-T1-E3	↳ SI1072X-T1-E3	⊛ SI1072X-T1-GE3	↔ SI1072X-T1-GE3	↔ SI1073X-T1-GE3
D SI1073X-T1-GE3	⊛ SI1120-A-GMR	↳ SI1132-A10-GMR	⊛ SI1133-AA00-GMR	↔ SI113DP-T1-GE3
⇒ SI1141-A10-GMR	↔ SI1142-A11-GMR	⊛ SI1143-A11-GMR	↳ SI1143-M01-GMR	↔ SI1144-AAGX-GMR
↔ SI1300BDL-T1-E3	⇒ SI1300BDL-T1-GE3	D SI1300BDL-T1-GE3	⊛ SI1300DL	↳ SI1300DL-T1
⊛ SI1300DL-T1-GE3	D SI1301DL	⇒ SI1301DL-T1	↔ SI1301DL-T1-E3	↔ SI1301DL-T1-GE3
↳ SI1301DL-T1/LGW	⊛ SI1302DL	↔ SI1302DL-T1-E3	⇒ SI1302DL-T1-E3	↔ SI1302DL-T1-GE3
⊛ SI1302DL-T1-GE3	↳ SI1303DL	⊛ SI1303DL-T1	D SI1303DL-T1-E3	↔ SI1303DL-T1-E3
↔ SI1303DL-T1-GE3	⊛ SI1303DL-T1-GE3	↳ SI1303DL-TL-E3	⊛ SI1303EDL-T1-GE3	↔ SI1304BDL-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited